



佐藤 公法¹, 上ヱ地 義徳¹, 沖津 康平² 長谷川 祐司¹, 松下 正³, 雨宮 慶幸^{1,4}

¹東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻*,²東京大学工学部総合試験所, ³高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所, ⁴東京大学大学院新領域創成科学研究科物質系専攻

X-ray Polarization-contrast Imaging

Kiminori SATO¹, Yoshinori UEJI¹, Kohei OKITSU² and Yoshiyuki AMEMIYA³

¹Department of Applied Physics, University of Tokyo ²Engineering Research Institute, University of Tokyo ³Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization (KEK) ⁴Department of Advanced Materials Science, University of Tokyo

X-ray polarization-contrast images due to X-ray natural linear dichroism (XNLD) and X-ray magnetic circular dichroism (XMCD) in hard X-ray region have been successfully recorded for the first time. The polarization imaging system consists of an X-ray polarizer, double X-ray phase retardes, and a high-spatial resolution X-ray CCD detector.

An hcp cobalt single crystal foil about 12 μ m thick, was used for XNLD imaging. The experiment was performed at X-ray energies of 23 eV and 29 eV above the cobalt K-edge (7709 eV), where the maximum linear dichroism (~3%) were observed with their signs reversed by using the X-ray polarimeter. The contrasts in the images at the two X-ray energies were reversed due to the XNLD in the sample.

An hcp cobalt poly-crystal foil about $4 \mu m$ thick, was used for XMCD imaging. The X-ray polarizationcontrast due to X-ray magnetic circular dichroism was observed at a photon energy of 10 eV above the cobalt K-absorption edge (7709 eV). The observed contrasts in the images were reversed by inversion of a magnetic field. Furthermore, the contrasts were reversed again at a photon energy of 32 eV above the cobalt K-absorption edge. These values of the contrast in the images due to the XNLD ($\sim 3\%$) and the XMCD ($\sim 0.3\%$) were in good agreement with those in the XNLD and XMCD spectra.

1. はじめに

シンクロトロン放射の偏光特性を活用した「新しいX 線計測技術の開発」という立場に立って、我々のグループ では、X線エリプソメータ(偏光解析器)の開発を行っ ている¹⁾。エリプソメトリー(偏光解析法)は、偏光状態 の分かった完全偏光の光を試料に入射し、反射・透過の際 の光の偏光状態の変化を測定し、試料の光学定数を求める 測定法である。開発したX線エリプソメータを用いると、 7~10 keVのX線領域で光学活性(またはファラデー効 果)、直線・円二色性、複屈折のスペクトルを高精度で測 定することができる^{2,3)}。我々は、この計測技術をイメー ジング技術と結びつけて、X線領域の偏光現象に起因す るコントラスト像を測定する「X線偏光顕微鏡」の開発 を現在行っている^{4,5)}。現時点では,空間分解能などの点 でまだ開発途上であるが,本特集「イメージング」で執筆 の機会を与えられたので,装置の概要,また,それを用い て測定した直線二色性および磁気円二色性に基づく偏光依 存の吸収コントラストイメージの測定について紹介する。

可視光領域において,物質と偏光の相互作用を利用した イメージング手法は,多結晶物質の結晶粒の観察,磁性体 の磁区構造の観察などの手段として広く普及している。最 近,軟X線領域では,偏光軟X線を用いた光電子顕微鏡 (PEEM)による「偏光顕微法」が磁性ミクロ構造の研究 において世界的に注目され,本特集でも取り上げられてい

^{*} 東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻 〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1 TEL 02 5841 6925 FAX 02 5941 6040 Final anti-Chalantic anti-Chalantic anti-

TEL: 03-5841-6825 FAX: 03-5841-6949 E-mail: sato@kohsai.t.u-tokyo.ac.jp amemiya@kohsai.t.u-tokyo.ac.jp

る。これに対して,硬X線領域での「偏光顕微法」の試 みは未だ行われていない。我々が知る限り、結晶の不完全 性を反映した偏光コントラスト像の測定があるのみであ る^{6,7)}。軟X線領域での「偏光顕微法」が硬X線領域に対 して先行している主な理由は、磁性を担う遷移金属の3d 軌道や希土類元素の 4f 軌道への電子遷移を直接観察でき るので大きな磁気二色性が得られ、磁性研究に適したエネ ルギー領域であるからであろう。しかし、歴史的には放射 光を用いた磁気円二色性の測定が初めて行われたのは硬 X線領域であったという事実⁸⁾を取っても、硬X線も十分 に磁性研究のプローブとしての可能性を有している⁹⁾。軟 X線と同様に元素選択的な測定が可能であるばかりでな く、高い透過能力を利用して表面でなくバルクの元素の磁 性についての情報を得ることができる。将来、トモグラフ ィーの手法を取り入れれば,3次元空間での磁性構造の研 究を行うことも可能になる。また、我々の方法は、光学素 子を用いて入射X線の偏光状態を制御するので、左右の 円偏光のスイッチングも縦横の直線偏光のスイッチングも 自由に行うことができ、円二色性イメージと直線二色性イ メージの同時・分離観察も行うことができる。磁性研究以 外でも,硬X線領域での「偏光顕微法」は,物質の深い エネルギー準位での光学異方性や光学活性のイメージング を可能にするので,新たな応用分野が開ける可能性を期待 している。

本稿では、始めに、X 線偏光コントラスト像を記録す る高分解能 CCD 型 X 線検出器について、次に、X 線偏光 をスイッチングするための光学系について述べる。最後に それらを組み合わせて行った、コバルト単結晶のX 線自 然直線二色性(XNLD)コントラスト像とコバルト多結 晶のX 線磁気円二色性(XMCD)コントラスト像の測定 を紹介する。

305

2. 高分解能 CCD 型 X 線検出器

我々が開発した CCD 型 X 線検出器は、蛍光体、拡大光 学レンズ,光学 CCD カメラ,カメラコントローラ,制御 コンピュータから構成されている (**Fig.1**)。X 線像は, 蛍光体により可視像に変換され,拡大光学レンズで拡大さ れて CCD 撮像素子に結像される。この CCD 型 X 線検出 器の空間分解能を決める要因は蛍光体である。すなわち, 蛍光体で変換された可視光像のボケが空間分解能を決定す る。高い空間分解能を得るには蛍光体を薄くする必要があ るが、それと同時に発光効率、発光の場所的不均一性も考 慮して蛍光体を最適化しなければならない。蛍光体の材 質,厚さ,塗布方法,基板の種類を変えて性能比較を行っ た(**Table 1**)。現段階では、ベリリウム基板に厚さ6 µm で沈殿塗布した Gd₂O₂S: Tb (P-43) を用いている。拡 大光学レンズの拡大率は、×2.5、×5、×10、×20、で変化 させることができる。光学 CCD カメラ(浜ホト製 C4880-40)の撮像素子は、冷却型インターライン読み出 しCCD (SONY 製 ICX-061) である。画素サイズは6.7 μ m×6.7 μ m, 画素数は1280 pixel×1024 pixel で, 10.0 mm×8.7 mmの有効面積を持つ。CCD撮像素子は、暗電 流を低減して長時間露光できるように、ペルチェ素子で -50℃に冷却して使用しているので, 暗電流は0.02 electrons/sec/pixel と極めて低い。また, CCD 撮像素子は



Figure 1. Schematic view of the X-ray CCD detector.

material	D [µm]	substrate	deposition	FWHM [µm]	$\eta_{ m y/e}$ [e-h/xph]	δΙ/Ι [%]
Gd ₂ O ₂ S:Tb (P-43)	12.6 4.9	aluminized Mylar	flow (horizontal)	36.5 ± 0.5 29.6 ± 0.7	1.71 1.05	14.7 41.1
	12~22 4~5		flow (incline)	$\begin{array}{c} 21.1 \pm 0.4 \\ 12.1 \pm 0.6 \end{array}$	1.46 0.76	40.0 21.8
	10 5~7	glass (3 mm)	sedimentation	7.9 ± 0.7 5.9 ± 0.4	0.60 0.36	10.9 14.3
	6	glass (0.5 mm)		5.1±0.5	0.37	17.1
	6	beryllium		5.3±0.4	0.34	13.6
CsI:Tl	6	glass (1 mm)	evaporation	9.8±0.9	0.10	17.7
Y ₃ Al ₅ O ₁₂ :Ce (YAG)	25	glass (3 mm)	glue	3.6±0.5	0.05	12.2

Table 1. Evaluation of phosphor screens. D, FWHM, $\eta_{v/e}$, and δI indicate the thickness, the spatial resolution, the conversion gain, and non-uniformity of response, respectively

Table 2. Components and performance characteristics of the X-ray CCD detector

Components					
Phosphor					
material: Gd ₂ O ₂ S: Tb (P-43)					
thickness: $6 \mu m$					
substrate: beryllium					
deposition: sedimentation					
spatial resolution: $5.3\pm0.4\mu\text{m}^{a}$					
conversion gain: 0.34 e-h/xph ^b					
Magnifying optical lens (CF IC EPI Plan, Nikon)					
numerical aperture (NA)					
×2.5: 0.075 ×5: 0.13 ×10: 0.3 ×20: 0.46					
CCD camera (C4880-40, HAMAMASTU)					
CCD type: Interline CCD, ICX-061, SONY					
number of pixel: 1280×1024					
size of pixel: 6.7 μ m × 6.7 μ m					
full-well capacity: 16,000 electrons					
active area: $10.0 \text{ mm} \times 8.7 \text{ mm}$					
operational temperature: $-40 \sim -50^{\circ}$ C					
readout time [frame/sec]: 0.22 or 5.36					
quantum efficiency: 42%°					
readout noise: 5 electron r.m.s.					
dark charge: 0.02 electron/sec/pixel ^d					
dynamic range: 3200					
ADC resolution: 16 bit					
gain [electron/ADC]: 0.06 or 0.13 or 0.38					

^a: FWHM of LSF at 7.709 keV.

^b: for 8 keV X-rays with magnifying optical lens $(\times 2.5)$.

°: at 540 nm.

^d: at −50°C.

250 nm から1000 nm の波長領域で分光感度特性を持ち, Gd₂O₂S:Tb (P-43)(主波長:545 nm)に対する量子効 率は約42%である。CCD 撮像素子からのアナログ出力は 増幅された後,16 bit デジタル画像に変換され,0.22 frame/sec の速度で計算機に取り込まれる。Table 2 に CCD 型 X 線検出器の性能特性を示す。

空間分解能をさらに向上させるために,Si(111)完全結 晶の非対称反射を用いたX線拡大器をCCD型X線検出 器の上流に配置したX線イメージングシステム(Fig.2) を製作し,その性能評価を行った。Figure 3 はX線拡大 結晶で一次元方向に拡大したニッケルメッシュ像を示す。 結晶拡大率は,それぞれ(a)×1.0,(b)×6.3,(c)×23.4であ る。Figure 4 にはタンタル板のエッジ像を示す(結晶拡 大率×12.8)。ナイフエッジでのフレネル回折像を観察す ることができる。Figure 4 の白線に沿った強度分布,お よびその理論計算値をFig.5 に示す。両者はよく一致し ている。フレネル回折像は,結晶拡大率×6.3以上で確認 されたので,結晶拡大率×6.3以上ではナイフエッジでの フレネル回折を考慮して空間分解能の評価を行った。

Figure 6 に結晶拡大率に対する空間分解能を示す。結



Figure 2. Experimental setup of the high-spatial-resolution X-ray CCD detector with one dimensional X-ray magnifier. The energy of the incident beam was tuned at 7.709 keV with a double-crystal Si(111) monochromator. The X-ray beam transmitted by the sample is vertically expanded by an asymmetrically-cut first crystal. The X-ray beam reflected back by a symmetrically-cut second crystal is incident on the X-ray CCD camera. The X-ray CCD camera is controlled by a personal computer via a serial data link. This imaging system can be extended to two-dimensional imaging system by placing another set of asymmetrically-cut crystal perpendicularly.



Figure 3. Images of nickel meshes with 20 μ m spacing taken with the X-ray CCD camera with the one-dimensional X-ray magnification. The magnification factors of the X-ray magnifier are (a) $\times 1.0$, (b) $\times 6.3$, and (c) $\times 23.4$.



Figure 4. Fresnel-diffraction image at the knife-edge with a magnification factor of $\times 12.8$.

晶拡大率を上げると空間分解能が向上するが、1µm 程度 で漸近する。この原因は、X線が結晶表面から結晶内に 進入することによって結晶内でビームが広がること、ま た、ビーム発散により試料から拡大結晶の間でビームが広 がりこと、であると考えられる。Figure 6の実線は、こ れらのビーム広がりを考慮して計算した空間分解能であ り、実験値と良く一致している。すなわち、結晶拡大を用 いて得られる空間分解能は、1µm 程度が限界であると結 論できる。2組のX線拡大結晶を互いに直交させて配置



Figure 5. The measured (open circles) and calculated (solid line) intensity profile across the knife-edge. The measured intensity profile was obtained along the white line in the Fresnel-diffraction image.



Figure 6. The measured spatial resolution in terms of full width at half-maximum (FWHM) of line spread function (LSF) achieved with the X-ray CCD detector with the one-dimensional X-ray magnification together with calculated curves. The solid line includes the effects of the blurring due to the extinction distance in crystal and delete the distance from the sample to the asymmetric crystal (70 mm).



Figure 7. X-ray image of nickel meshes with $20 \,\mu m$ spacing taken with the X-ray CCD camera with two-dimensional X-ray magnification. The magnification factors are $\times 6.3$ in the horizontal direction, and $\times 7.1$ in the vertical direction.

すれば,2次元的にX線像を拡大することができる。 Figure 7には,ニッケルメッシュ像を2組のX線拡大結 晶で2次元的に拡大したX線吸収画像を示す。

3. X線偏光スイッチング

X線領域の直線偏光依存の吸収スペクトルは, Templeton らによって、1980年に初めて測定された10)。彼らは、 偏光電磁石の on-axis の直線偏光 X 線を用いて, 試料を光 軸周りに90度回転する方法で,直線二色性のスペクトル を測定した。この方法は、偏光 XAFS として最近応用が 広がりつつある11)。しかしながら、この方法は試料の厚 さムラ、ビーム強度の場所ムラの影響を受けやすく、直線 偏光コントラストのイメージング法にまで拡張することは できない。また、円二色性スペクトルの測定は、1987年 に Schutz らによって偏光電磁石の off-axis の楕円偏光を 用いて行われた⁸⁾。その後,円偏光X線を発生する挿入光 源を用いた磁気円二色性スペクトルの測定もさかんになり つつある。off-axis による円偏光硬 X 線を利用する場合, X線強度が off-axis で減少する程度が大きいこともあり, 軟X線のようには高い円偏光度を得ることはできない。 (強度15%で、円偏光度90%)また、円偏光を発生する挿 入光源を用いる場合でも,下流に設置する光学素子の影響 で偏光度が低下するという問題がある。これに対して、透 過型 X 線移相子を用いて X 線の偏光状態を制御し,縦偏 光と横偏光、または右円偏光と左円偏光をスイッチングす る方法は、高い偏光度を得られると云う点で、また、ビー ム位置変動やビーム内強度分布の影響を受けないと云う点 で、偏光コントラストをイメージングする為の偏光生成手 法として優れている。しかし,既存の透過型 X 線移相子 を用いた場合、移相子への入射ビームの角度発散に伴う収 差(光軸収差)や移相子結晶内部でのX線のポインティ ングベクトルのずれに起因する出射ビーム位置の変動とい う問題が存在する。さらに、移相子をビーム軸に挿入した ままでの水平偏光の生成では,移相子をブラッグ角から十 分に離さなければならないので、水平偏光と垂直偏光の高 速スイッチングは困難となる。

そこで、これらの問題を解決するために我々は収差補償 型X線移相子を開発した。収差補償型X線移相子は、著 者の一人(K.O.)が発案したもので、二枚の透過型移相 子を組み合わせて光軸収差を補償する二象限移相子12), および、四枚の透過型移相子を組み合わせて光軸収差と色 収差を同時に補償する四象限移相子がある。前者のタイプ は,二枚の透過型移相子を,ブラック反射がお互いが逆方 向になるように配置したものである。この場合, X線の ビーム角度広がりに対する第一移相子と第二移相子の移相 差の勾配が逆方向となり、光軸収差を相殺することができ る。また、第一移相子と第二移相子のポインティングベク トルのずれの方向も逆になるので、入射位置と出射位置は 一致する。水平偏光を生成する際も、第一移相子と第二移 相子で作る移相シフトを逆にすれば、移相子をブラッグ角 から大きく離さなくても良い。このため、水平偏光と垂直 偏光の高速スイッチングも容易に行える。

X線偏光子によって得た水平偏光を移相子によって垂

直偏光に変換する場合,得られる垂直偏光の直線偏光度 は,従来の一枚移相子では89%,二象限移相子では95%, 四象限移相子では99%である。移相子によるX線透過率 は,コバルト吸収端でそれぞれ60%,36%,13%,ニッケ ル吸収端ではそれぞれ70%,49%,24%である。

4. X線偏光コントラストイメージング

4.1 実験配置

前述した高分解能 CCD 型 X 線検出器と X 線偏光スイ ッチング光学素子を組み合わせて製作したX線偏光コン トラストイメージングの実験配置を Fig.8 に示す。X線 偏光スイッチング光学素子は、4回のブラッグ反射を与え るシリコン422チャンネルカットのX線偏光子,2枚のダ イヤモンド111透過型X線移相子から成る。透過型X線 移相子は, 面方位〈001〉, 厚さ約300 µm のダイヤモンド 結晶である。移相子は、111反射を与え、散乱面が水平面 から45°傾いている。白色の放射光ビームは、X線偏光子 により単色化されかつ高度の水平直線偏光に変換される。 このX線ビームは2枚の透過型X線移相子に入射し、そ こで水平偏光と垂直偏光, または, 右円偏光と左円偏光に スイッチングされる。ここで生成される X 線偏光の水平 偏光度は99.99%, 垂直偏光度は95%である。また, 左右 の円偏光度は95%以上と見積もられる。試料を透過した X線像は高分解能CCD型X線検出器で記録される。X 線のエネルギーはコバルトK吸収端(7709 eV)近傍に 調整した。

4.2 解析方法

ここでは、偏光コントラスト像を得る手順を簡単に述べる。試料を透過した X 線画像 $I_t(r)$ は、CCD 型 X 線検出器の暗電流を差し引いた後、試料の上流のイオンチェンバー (IC₂) で強度の規格化を行うことによって得られる。 試料がないときの X 線画像 $I_0(r)$ を同様に求め、これらの画像からある偏光状態での吸収コントラスト像を $-\log(I_t(r)/I_0(r))$ によって求める。ここで得た吸収コントラスト像では、検出器の感度ムラおよび入射 X 線ビーム内での強度ムラによるコントラストが自動的に補正されている。しかし、試料の厚さムラによるコントラストが含まれてい るので、その影響を補正して偏光によるコントラストを抽 出する必要がある。我々は入射 X 線の偏光をスイッチン グして試料の吸収コントラスト像を得ているので、試料の 厚さムラによるコントラストを差し引くには、ただ単に水 平偏光と垂直偏光に対する吸収コントラスト画像の差(ま たは右円偏光と左円偏光に対する吸収画像の差)を求め、 それをそれぞれの吸収コントラスト画像の和で割れば良 い。すなわち、

$$XLD(\mathbf{r}) = \frac{\mu_{1}(\mathbf{r}) - \mu_{2}(\mathbf{r})}{\mu_{1}(\mathbf{r}) + \mu_{2}(\mathbf{r})}$$
$$= \frac{t(\mathbf{r})}{t(\mathbf{r})} \cdot \frac{\mu_{1}(\mathbf{r}) - \mu_{2}(\mathbf{r})}{\mu_{1}(\mathbf{r}) + \mu_{2}(\mathbf{r})}$$
$$= \frac{(\mu t)_{1}(\mathbf{r}) - (\mu t)_{2}(\mathbf{r})}{(\mu t)_{1}(\mathbf{r}) + (\mu t)_{2}(\mathbf{r})}$$
$$= \frac{\log \left(\frac{I_{t}}{I_{0}}\right)_{1} - \log \left(\frac{I_{t}}{I_{0}}\right)_{2}}{\log \left(\frac{I_{t}}{I_{0}}\right)_{1} + \log \left(\frac{I_{t}}{I_{0}}\right)_{2}}$$

により, 偏光に起因するコントラストのみを抽出して画像 化することができる。最後に, X線光子統計や CCD の読 み取りノイズによる揺らぎノイズを減少させるために10 ピクセル×10ピクセルを束にする処理(ビニング処理) を行い偏光コントラスト画像を得る。

5. X線偏光イメージングの応用

5.1 X線自然直線二色性偏光コントラストの観測

試料としてコバルトhcp単結晶を用いた。この試料は 厚さ12μmの薄片で,異方軸であるc軸が薄片面内にあ る。まず始めに,我々は,四象限移相子を用いてコバルト K吸収端(7709 eV)近傍で,X線直線二色性スペクトル を測定した。四象限移相子で生成されるX線ビームの水 平偏光度は99.99%,垂直偏光度は99%である。エネルギ ー掃引は,X線偏光子のブラッグ角を変化させながら,1 eVのエネルギーステップで行った。Figure 9にX線直 線二色性スペクトル(実線)と吸収曲線(波線)を示す。 測定されたX線直線二色性スペクトルは、コバルトK吸



Figure 8. Experimental setup for imaging due to X-ray dichroism. MP, silicon 4 2 2 monochromating polarizer; PR_1 and PR_2 , first and second diamond 1 1 1 phase retarders; PD_1 , PIN photo-diode monitoring X-rays reflected by the first phase retarder; PD_2 , PIN photo-diode monitoring X-rays reflected by the second phase retarder; IC, ionization chamber monitoring X-rays incident to the sample; S, sample.



Figure 9. X-ray linear dichroism (XLD) spectrum of a hcp cobalt single crystal with its absorption spectrum, which was measured with the quadruple X-ray phase retarders.



Figure 10. Arrangement of three pieces of the hcp cobalt single crystals in the CCD field of view. Directions of c-axes are indicated by arrows.

収端(7709 eV)の高エネルギー側23 eV と29 eV でそれ ぞれマイナス3%,プラス3%のピークを示す。そこで, X線直線二色性による最大の偏光コントラストが観察で きるように,X線エネルギーをこの2つエネルギーに固 定してイメージングの実験を行った。

イメージングの実験では,試料のコバルトhcp単結晶 を3つに分割し, c軸が面内で水平軸からそれぞれ0 deg.,45 deg.,90 deg.になるように回転して置き,それら が CCD型X線検出器の視野の中に入るように配置した (**Fig. 10**)。ここでは,この3つの領域をエリア1 (90 deg.),エリア2 (0 deg.),エリア3 (45 deg.) と呼ぶこ とにする。CCD型X線検出器の視野は,約686 μ m×858 μ m である。

Figure 11に試料の厚さムラによるコントラスト像を示 す。画像の中の黒の部分は透過X線の強度が高く,白の 部分は低いことを表す。画像の中に示されている数値は, それぞれの位置における試料の厚さを示している。

画像演算により,試料の厚さムラを相殺して得られた自 然直線二色性による偏光コントラスト像を Fig. 12に示 す。コバルト K 吸収端(7709 eV)から23 eV 高いエネル ギーでは,エリア 1,2,3 はそれぞれ,白,黒,グレーを 示した。これは,透過 X 線の強度がエリア 1 で最も高く,



Figure 11. Image with contrasts due to non-uniformity of the sample thickness at an X-ray energy of 7732 eV (23 eV above the cobalt K-edge). The numerals marked in the image indicate the thicknesses of respective positions.





Figure 12. Images due to X-ray linear dichroism (XLD) taken at 23 eV (a), and 29 eV (b) above the cobalt K-edge after the correction with non-uniformity of the sample thickness.

エリア2で最も低いということを表している。それぞれ のエリアの画素値の平均値からX線直線二色性の大きさ を計算すると、エリア1,2,3でそれぞれ0.027,-0.023, -0.013であった。コバルトK吸収端(7709 eV)から29 eV高いエネルギーでのコントラストは、エリア3では変 わらず、エリア1とエリア2で反転した。この時、各エ リアの画素値の平均値から求めたX線直線二色性の値は、 エリア1,2,3 でそれぞれ-0.020,0.024,-0.010である。 これらの値は、四象限移相子を用いて測定した X 線直線 二色性スペクトルの値とほぼ一致している。従って、これ らのコントラストは、c 軸の配向、つまり、hcp コバルト 単結晶の X 線直線二色性に起因していると結論づけるこ とができる。

ここで、直線二色性によるコントラストの検出限界について考察してみたい。我々は偏光をスイッチングしてコントラスト像を測定しているので、検出器の場所的な感度ムラ、入射 X 線ビーム内の強度ムラに起因するコントラストの影響を受けずに測定を行うことができる。また、試料の厚さムラによるコントラストも相殺することができる。 従って、系統的な誤差はすべて相殺されるので、統計的な揺らぎのみを考察すれば良い。Figure 12(a)の実線に沿った直線二色性プロファイルを Fig. 13に示す。Figure 13(a)と(b)は、それぞれ10ピクセル×10ピクセルのビニング処理の前後のプロファイルを示す。直線二色性コントラストに現れる揺らぎ(σ_{xLD})は、次式に示すように、X 線光子統計に起因する揺らぎ($\sigma_{readout}$)で説明することができる。



 $\sigma_{\rm XLD} = \sqrt{\sigma_{\rm xph}^2 + \sigma_{\rm readout}^2}$





(b)

Figure 13. X-ray linear dichroism (XLD) profiles along the line in Fig. 12(a). (a) without a binning, (b) with a 10×10 binning.

CCD 読み出しノイズに起因する揺らぎ ($\sigma_{readout}$) は, CCD の読み出しノイズ (~5 e-h rms) と AD コンバータ ーの増幅率(0.06 e-h/ADC)から4.3×10⁻²と見積るこ とができる。これに対して、光子統計に起因する揺らぎ (σ_{xph})は,光子・信号変換率(0.34 e-h/xph)から約2.1 ×10⁻¹と見積もられる。しかし、CCD型X線検出器の 空間分解能が約5.3 µm (画像ピクセル約10個に相当) で あるため、隣接ピクセル間での信号のクロストーク、つま り、ボケのために信号の平均化操作が起き、光子統計に起 因する揺らぎ (σ_{xph}) は約1/10程度になる。その結果,光 子統計に起因する揺らぎ(σ_{xph})は、約 2.1×10^{-2} となり、 CCD 読み出しノイズによる揺らぎ(4.3×10-2) と合わせ ると、全統計揺らぎは約4.8×10⁻²となる。この値は、 Fig. 13(a)の統計揺らぎ~5×10⁻² とほぼ一致するので, この2つの統計揺らぎにより偏光コントラスト像の揺ら ぎを説明できると考えられる。

10ピクセル×10ピクセルのビニング処理によって,直 線二色性コントラストの揺らぎは,ビニング処理前の1/ 10(~5×10⁻³)に減少する。CCD型X線検出器の点像分 布関数の半値幅(~5 μ m)は,画像のピクセルサイズの 約10倍であるので,ビニング処理による空間分解能の劣 化は無視できる程度である。

ところで、本測定法では、検出器の場所的な感度ムラ, 入射X線ビーム内の強度ムラに起因するコントラストの 影響を受けずに測定を行うことができると云うことが大き なメリットである。その結果、コントラストを制限する要 因として光子統計に起因する揺らぎ(σ_{xph})と CCD 読み 出しノイズに起因する揺らぎ($\sigma_{readout}$)のみを考慮すれば 良い。これらはどちらも、測定時間および測定回数を増や せばそれに従って小さくすることができる。

5.2 X線磁気円二色性(MCD) 偏光コントラストの観測 試料は,厚さ4µmのhcpコバルト多結晶を用いた。ま ず始めに,我々は,二象限移相子を用いてコバルトK吸 収端(7709 eV)近傍で,X線円二色性スペクトルを測定 した。試料は,793 gaussの磁場の中に入射X線の方向か ら45 deg.傾けて配置した。エネルギー掃引は,X線偏光 子のブラッグ角を変化させながら,1 eVのエネルギース テップで行い,2本のX線磁気円二色性スペクトルを磁 場の方向を逆転させて測定した。Figure 14にX線円二色 性スペクトル(実線)と吸収曲線(波線)を示す。得られ たX線磁気円二色性スペクトルは,コバルトK吸収端 (7709 eV)から10 eV高いエネルギーと32 eV高いエネル ギーで±0.3%,±0.2%のピークを示す。イメージングの 実験は,この二つのX線エネルギーで行った。

MCD イメージング実験では, 試料を二つに分割し, 円 偏光 X 線のスピンの方向が, 試料の磁化方向に対してそ れぞれ平行・反平行となるように磁場(793 gauss)の中 に配置し, 二つの試料を透過した偏光 X 線が CCD 型 X 線検出器の視野の中にはいるように配置した(Fig. 15)。 磁場の方向は,試料の表面とそれぞれ+45 deg., -45 deg.をなしている。

画像演算により, 試料の厚さムラを相殺した後のX線 磁気円二色性(MCD) 偏光コントラストを Fig. 16に示 す。イメージングは, 磁気円二色性の値が最大(+0.3%) を示しているコバルトK吸収端(7709 eV)から10 eV 高



Figure 14. X-ray magnetic circular dichroism (MCD) spectra (solid line and dashed line) in hcp cobalt poly-crystals with the absorption spectrum (dotted line), which were measured by the X-ray polarimeter. These spectra were recorded with opposite magnetic fields, parallel (solid line) and anti-parallel (dashed line) to the photon spin direction.



Figure 15. Plan view of the arrangement around the sample. The photon spin direction of circular polarization and the magnetization direction were parallel in one area while anti-parallel in another area.

いエネルギー(a),同じエネルギーで磁場の方向を反転さ せた状態(b),X線磁気円二色性の符号が反転する値 (+0.2%)を示すコバルトK吸収端から32 eV高いエネ ルギー(c)で行った。(a)における画像には、ふたつのエリ アにコントラストが見られる。このコントラストは、磁場 の方向の反転により反転した(b)。さらに,エネルギー を変化させることによって再びコントラストが反転した (c)。従って、これらのコントラストは、磁化方向、つま り,hcpコバルト多結晶のX線磁気円二色性に起因して いると結論づけることができる。画像中に示している数値 は、CCD 型 X 線検出器で得られた画像の強度データから 求めた X 線磁気円二色性の値で,スペクトロスコピーに よる値とほぼ一致していることがわかる。しかしながら, X線直線二色性の場合と同様にわずかな差が見られる。 これは、X線磁気円二色性イメージングとスペクトロス コピーの試料の配置の相違から来ると考えられる。

Figure 16のX線磁気円二色性偏光コントラストに見られる統計的な揺らぎは,X線自然直線二色性偏光コントラストのそれと同様に,光子統計とCCD読み出しノイズに起因する統計揺らぎで説明できる。

6. まとめ

我々が現在開発している X 線偏光顕微鏡の方法・原理 とそれを用いて測定した偏光コントラスト像について紹介 した。ただし、ここで紹介した観察例は、硬 X 線領域の 偏光コントラスト像が観察できるということを示しただけ で、顕微といえる空間分解能での観察例ではない。しかし ながら、現時点では、高分解能 CCD 型 X 線検出器の空間 分解能 (5 μ m) で0.1%程度の偏光コントラストのイメー ジングを行うことは可能である。また、非対称反射を用い た結晶拡大器を高分解能 CCD 型 X 線検出器に組み合わせ てイメージングを行えば、空間分解能は 1 μ m 程度まで向 上する。さらに空間分解能を上げるためには、試料の下流 に結像ゾーンプレートを置き、高分解能 CCD 型 X 線検出 器に拡大像を結像させる方法を採用したいと考えている。 この場合、空間分解能は0.15 μ m に向上することが期待で きる。また、硬 X 線の高い透過力を生かしてトモグラフ



Figure 16. Images due to X-ray magnetic circular dichroism (MCD) taken at 10 eV ((a), (b)) and 32 eV (c) above the K-absorption edge (7709 eV) after the correction with the non-uniformity of the sample thickness.

ィーの手法を導入して、3次元空間の構造による偏光コン トラスト像を観察することにも挑戦したいと考えている。

本研究は, PF の共同利用実験課題(No. 97G-075)として行われた。

参考文献

- 上 上 2 地 義 徳, 沖 津康平, 佐藤公法, 雨宮慶幸:日本放射光 学会誌 13,48 (2000).
- K. Okitsu, T. Oguchi, H. Maruyama and Y. Amemiya: J. Synchrotron Rad. 5, 995 (1998).
- 3) K. Okitsu, Y. Ueji, T. Oguchi, Y. Hasegawa, Y. Ohashi and Y. Amemiya: J. Synchrotron Rad. 5, 1055 (1998).
- 4) K. Sato, Y. Hasegawa, K. Kondo, K. Miyazaki, T. Matsushi-

ta and Y. Amemiya: submitted to Rev. Sci. Instrum.

- 5) K. Sato, K. Okitsu, Y. Ueji, T. Matsushita and Y. Amemiya: submitted to J. Synchrotron Rad.
- 6) K. Okitsu: J. Phys. Soc. Jpn. 62, 911 (1993).
- 7) K. Hirano: J. Appl. Phys. 79, 3365 (1996).
- G. Schutz, W. Wagner, W. Wilhelm, P. Kienle, R. Zeller, R. Frahm and G. Materlik: Phys. Rev. Lett. 58, 737 (1987).
- 9) 圓山 裕:固体物理 28,453 (1993).
- D. H. Templeton and L. K. Templeton: Acta Cryst. A 36, 237 (1980).
- 11) K. Asakura, T. Kubota, W. J. Chun, Y. Iwasawa, K. Ohtani and T. Fujikawa: J. Synchrotron Rad. 6, 439 (1999).
- 12) K. Okitsu, Y. Ueji, K. Sato and Y. Amemiya: submitted to J. Synchrotron Rad.